

## 1 主要用途及主要特点

### 1.1 主要用途

用 W1XS003C 封装的成品管主要用于低压整流电路上。

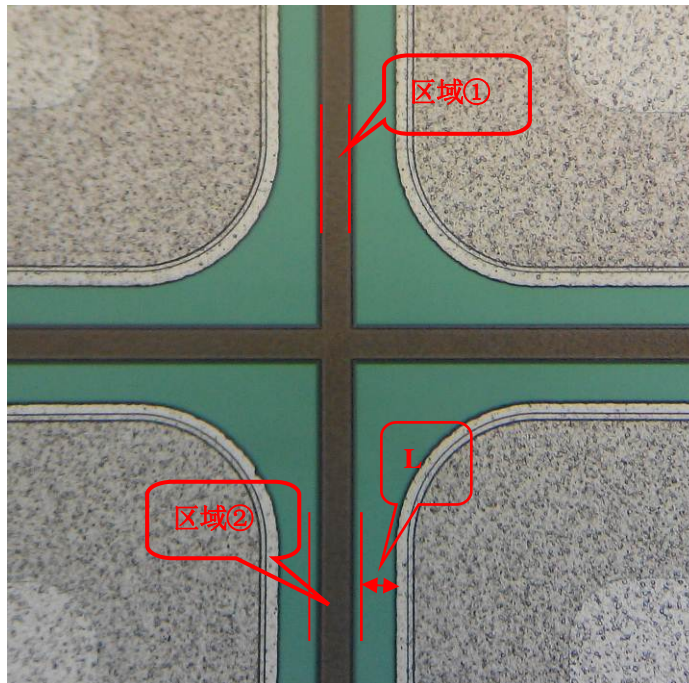
### 1.2 主要特点

- 低正向压降
- 高电导性
- 高可靠性

## 2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸		0.75 mm×0.75 mm	
			29.53 mil×29.53 mil	
	芯片厚度 (μm) (推荐)		220±20	
	划片道*尺寸 (μm)		40	
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	正面	400×400	
	正面电极 (阳极)	金属	铝	
		厚度 (μm)	5.0±1.0	
	背面电极 (阴极)	表层金属	金	银
	装片要求 (推荐)		共晶	低温共晶
	硅片直径 (mm)		φ 125	
	键合要求 (推荐)		2 根 φ32 μm 铜线	

\* 划片道位置示意图:



备注: 区域①为划片刀走刀区域, 划片时应在两条参考线中间; 区域②为划片道区域, 宽度为 40 μm; 划片时划片道边缘到铝的距离 L 不小于 24 μm 即判定为合格。

## 江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号  
电话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)  
传真: (0510) 86851532



### 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

#### 3.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

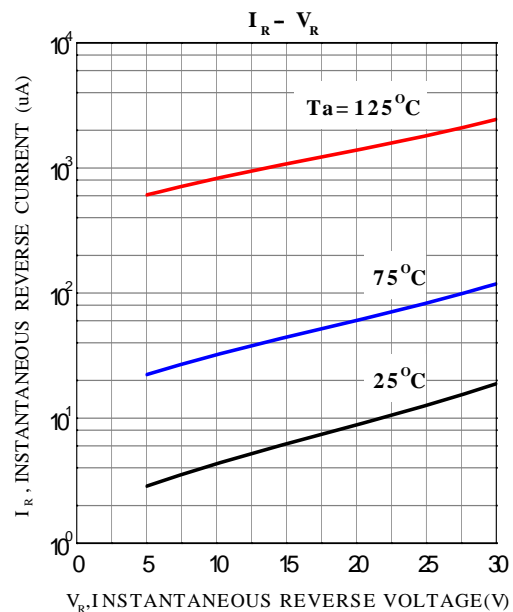
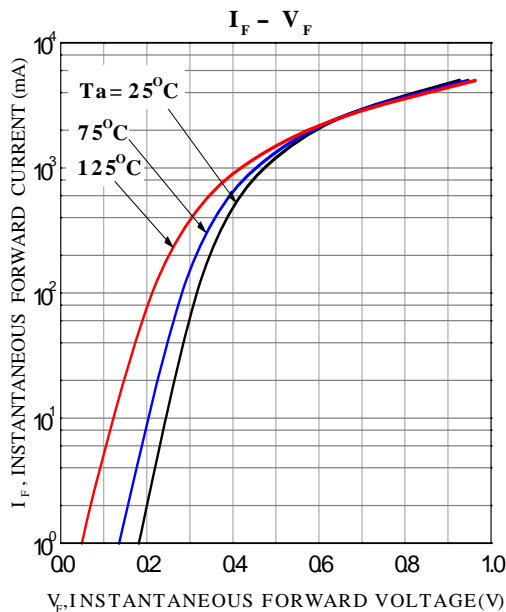
参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	$V_{RM}$	30	V	推荐封装形式: SOD-123 推荐成品型号: B5818
正向电流	$I_D$	1	A	
结温	$T_j$	110	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	$T_{stg}$	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

#### 3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	$V_{BR}$	$I_R=0.1\text{mA}$	30	—	—	V
反向电流	$I_R$	$V_R=30\text{V}$	—	20	100	$\mu\text{A}$
正向电压	$V_{F1}$	$I_{F1}=1\text{A}$	—	0.48	0.55	V
正向电压	$V_{F2}$	$I_{F2}=3\text{A}$	—	0.7	0.85	V
总电容	$C_{tot}$	$V_R=4\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	50	120	pF

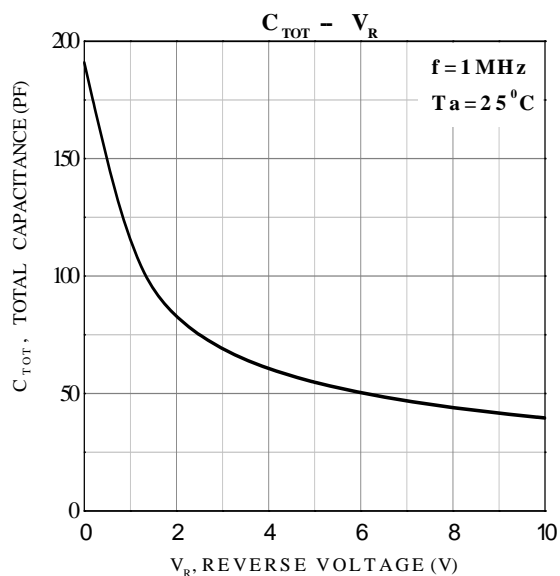
#### 3.3 典型特性曲线





江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片  
W1XS003C(单胞)  
肖特基二极管

文件编号	XS-R-046
版本号	18-B3-05
页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度  $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度  $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号  
电话：(0510) 86851182

网址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)  
传真：(0510) 86851532